# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305915

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 7/20

(21)Application number: 03-094867

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

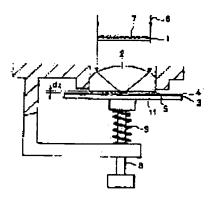
(72)Inventor: OZEKI HISAO

MATSUBARA TAKASHI

## (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device. CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

## 特開平4-305915

(43)公開日 平成4年(1982)10月28日

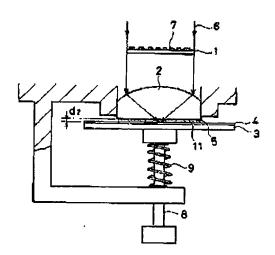
(51) Int CI. <sup>3</sup> H 0 1 L 21/627 G 0 3 F 7/20	織別配号	庁內整理番号	F J	技術表示管所
	5 2 1	7818-2H 7352-4M	HOIL	21/30 3 1 1 A
			!	審査論求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)
(21)出顯語号	特膜平3-94867		(71)出題人	000004112 特式会社ニコン
(22) 出願日	平成3年(1991)4.	月2日		東京客千代田区丸の内3丁目2番3号
			(72) 発明者	大関 尚夫
				東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大井銀作所内
			(72) 発明者	
				東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式 会社ニコン大弁製作所内
			(74)代理人	<b>弁理士 山川 政教</b>

## (54) 【発明の名称】 密管型質光接置

#### (57) 【張約】

【目的】 密着型爾光装置において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される浸液の膜壁を 尊くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを経減防止す ることを目的とする。

【構成】 フォトレジスト4を塗布されたウエハ3を露 光レンズ2に長級5を介して密着させる。 複数5にはフォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、 界面衝性剤11は、 浸液5の表面張力を減らし、満れ性を高める。 したがって、 浸液の膜厚 dr は界面活性剤を混入しない場合より薄くなる。



(2)

特開平4-305915

【特許請求の範囲】

【競求項1】 フォトレジストを塗布されたウエハを投 **多光学系もしくはフォトマスクに混液を介して答着さ** せ、限射光の照射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにした密着図鑑光装置に おいて、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えな い範囲で昇間提性剤が温入されていることを特徴とする 密省到露光装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【意業上の利用分身】本発明は、LSIの軽造工程にお いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に役影露光 する解光装置、特に密着型露光装置に関するものであ

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を展射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の学達 体基板上に投影器光するこの種の露光装置における露光 方式としては、①密治(コンタクト)酸光方式、②プロ キシミティ蘇光方式、③反射型投影蘇光方式、④縮小レ 20 ンズ投影観光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着展光方式は、フォトマスク (または役形光学系) とウエハとを密着させて離光する もので、これらが完全に密着している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。この店着は真空吸者、静電チャック等に よって行っている。しかし、完全な密券を実現すること は極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的 に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォー約 トマスクに欠陥が至じ、その寿命を低下させると同時に デバイスの参留りに影響を及ぼすといった問題があっ <u>جہ</u>

【0004】そこで、密着露光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に液体 (侵渡)を充填している。図2はウエハを浸液を介して 役影光学系に密若させた場合を示すもので、1はフォト マスク、2は投影光学系の一部を構成する露光レンズ、 3はフォトレジスト4が塗布されたウエハ、5は露光レ ンズ2とウエハ3間に充填された浸斂、6はフォトマス 40 ク1のパターン7を照射しフォトレジスト4を観光する 照射光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8 を上方に付券しウエハ3を露光レンズ2に所定圧にて押 し付ける圧縮コイルばねである。 限射光6の被長は短い ほど回折の影響が少なく、そのため光源としてエキシマ レーザー等のレーザー装置が用いられる。 浸液 5 として は、屈折率がフォトレジスト4と同程度で光の吸収が少 なく、しかもフォトレジスト4を密かさないものが望ま しく、通常純水が使用される。

[0005]

【発明が無決しようとする課題】しかしながら、上述し たような役後5を使用した協着型盤光装置においては、 侵破5自身の膜厚ムラがあると、浸液5による照射光6 の吸収量にムラが生じるため、コンタクト處光されたフ ォトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような個光ムラの発生を防止する

ため、侵被5の濡れ性を高めて表面張力を下げ、膜厚は

2

1 を魅力薄くすることが望まれている。 【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び奥望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、没彼の環厚を薄くし、没彼による露光ムラを軽減防 止し得るようにした鬱着型露光装置を提供することにあ

[0007]

【課題を祭決するための学授】本発明は上記目的を達成 するため、フォトレジストを隆布されたウエハを投影光 学系もしくはフォトマスクに没液を介して密着させ、照 射光の限射によりフォトマスクのパターンを前記フォト レジストに転写するようにした密着型解光装置におい て、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えない範 囲で界面活性剤が混入されているものである。

[0008]

【作用】本発明において界面活性剤は浸液の漏れ性を高 め、表面張力を下げる。したがって投続の膜厚を薄くす ۵.

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型電光波隆の 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一義成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。

【0010】本実施例は投影光学系にウェハを密着させ た場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の一部を 構成する超光レンズ2とウエハ3との間に介在される純 水等の浸液5に界面話性剤11を混入したものである。

【0011】界面活性剤11としては、隔イオン性、陰 イオン性、非イオン性等徴々のものが使用可能である が、屈折率が浸被5と同程度で光の吸収が少なく、また フォトレジスト4を落かしたりすることのない範囲で混 入されることが望ましい。特に、陽イオン性のうち四級 アンモニウム塩系は、涸れ佐も高く、レジストへの影響 も少なく、光の吸収も少ないため好ましい。

【0012】かくしてこのような構成においては界面活 性剤11が浸液5の表面張力を減らして濡れ性を高める ため、ウエハ3を所定圧力にて露光レンズ2に圧接した 際、浸液5の膜厚付2 を図2に示した従来装置と比較し て群くする(dz くdz)ことができ、また頭厚が輝く なれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光

50 の吸収ムラが減少し、露光ムラを軽減防止することがで

--86--

(3)

特開平4-305915

きるものである.

[0013]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密希型 露光装置によれば、経接に界面活性剤を混入することに より、侵被自身の表面張力を減らして濡れ性を向上させ るようにしたので、侵被の襲撃を得くすることができ る。したがって、浸液の膜厚ムラが小さく、光の吸収を 少なくすることができ、浸椒による腐光ムラを軽減防止 することができる。

3

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型離光装配の一実施鋼を示す 要都の断面図である。

【図2】密着型質光弦像の従来例を示す要部の断面図で ある.

### 【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 銭光レンズ
- ウエハ
- フォトレジスト
- 5 浸液
- 風射光
- 10 7 マスク
  - 11 界面報任利

